PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-223722

(43) Date of publication of application: 26.08.1997

(51)Int.Cl.

H01L 21/60 // H01L 21/68

(21)Application number: 08-027989

(71)Applicant: TOSHIBA MICROELECTRON CORP

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

15.02.1996

(72)Inventor: TAKUBO TOMOAKI

TAZAWA HIROSHI HOSOMI HIDEKAZU

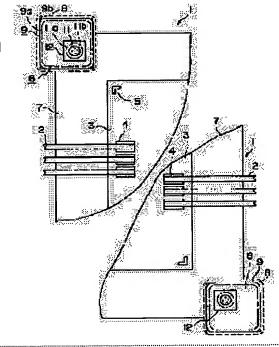
SHIBAZAKI YASUSHI

(54) POSITION RECOGNIZING MARK, TAB TAPE, SEMICONDUCTOR DEVICE AND PRINTED CIRCUIT **BOARD**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device and printed circuit board having little deviation of connected parts and good yield, position recognizing mark and TAB tape therefor.

SOLUTION: A position recognizing mark 6 has a pattern 9, 11 having ratios Xb/Xa and Yb/Ya, each equal to or less 0.5 where x-axis and yaxis are mutually perpendicular, Xa and Xb are sums of x- and ycomponents of vectors representing straight lines of the linearly approximated contour, A TAB tape 1 has a resin-made tape having a device hole 7 and inner leads 2 which are formed on this tape and connected to corresponding bumps 4 of a semiconductor chip 3 mounted in the hole 7. A semiconductor device has a semiconductor chip 3 disposed in the hole 7 and bumps 4 on this chip.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

23.07.2002

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-223722

(43)公開日 平成9年(1997)8月26日

(51) Int.Cl. ⁶	酸別配号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
HO1L 21/60	3 1 1		H01L 21/60	3 1 1 W	
# HO1L 21/68			21/68	F	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 11 頁)

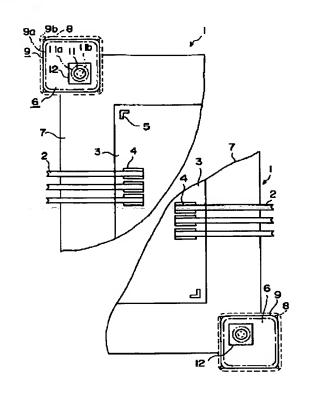
(21)出願番号	特願平8-27989	(71)出願人 000221199
		東芝マイクロエレクトロニクス株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)2月15日	神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1
		(71)出願人 000003078
		株式会社東芝
		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 田窪 知章
		神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
		式会社東芝研究開発センター内
		(72)発明者 田沢 浩
		神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
		式会社東芝研究開発センター内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦
		最終頁に続く

(54) [発明の名称] 位置認識マーク及びTABテープ及び半導体装置及びプリント基板

(57)【要約】

【課題】接続部のずれが少なく歩留まりが良い半導体装置及びプリント基板及びそのための位置認識マーク及び TABテープを提供することを目的としている。

【解決手段】互いに直交する×軸及び×軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベクトルの×成分の絶対値の合計×aに対する×成分の合計×bの割合×b/×a、及び、前記ベクトルのy成分の絶対値の合計 Yaに対するy成分の合計 Ybの割合 Yb/Yaが共に 0.5以下となるパターン9,11を有する位置認識マーク6を備えている。デバイスホール7を有し樹脂によって形成されたテーブと、前記テープ上に形成され、デバイスホール7に配置される半導体チップ3上の複数のバンブ4に対応して接続される複数のインナーリード2とを有するTABテープ1を備えている。また、前記デバイスホール7に配置された半導体チップ3と、前記半導体チップ3上の複数のバンブ4とを備えている半導体装置。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】互いに直交するx軸及びy軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx成分の合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy成分の絶対値の合計Yaに対するy成分の合計Ybの割合の少なくとも一方が0.5以下となるパターンを有し、

二つの前記バターンの画像を記憶すると共に二つの前記画像の2次元の相互相関関数を計算する位置認識装置によって前記二つの位置の前記バターンの相対位置を算出 10 して位置ずれが検出されることを特徴とする位置認識マーク

【請求項2】前配X b と前記Y b とが共に0でない場合、前記X b と前記Y b との比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする請求項1記載の位置認識マーク。

【請求項3】デバイスホールを有し、樹脂によって形成 されたテープと、

前記テープ上に形成され、互いに直交する x 軸及び y 軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベク 20 トルの x 成分の絶対値の合計 X b の割合、及び前記ベクトルの y 成分の絶対値の合計 Y a に対する y 成分の合計 Y b の割合が共に 0.5以下となるパターンを有する位置認識マークと、

前記テープ上に形成され、デバイスホール内に配置される半導体チップ上の複数のバンプに対応して接続される複数のリードとを備えたことを特徴とするTABテープ。

【請求項4】前記X b と前記Y b とが共に0でない場合、前記X b と前記Y b との比が0.8以上1.2以下30であることを特徴とする請求項3記載のTABテープ。 【請求項5】デバイスホールを有し樹脂によって形成されたテープと、互いに直交する x 軸及び y 軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベクトルの x 成分の絶対値の合計X a に対する x 成分の合計X b の割合、及び前記ベクトルの y 成分の絶対値の合計Y a に対する y 成分の合計Y b の割合が共に0.5以下となるパターンが前記テープ上に形成された位置認識マークと、デバイスホール内に配置される半導体チップ上の複数のバンプに対応して接続される前記テープ上の複数のリー40下とからなるTABテープと、

前記デバイスホール内に配置された半導体チップと、 前記半導体チップ上に形成され、前記TABテープの複 数のリードに対応して接続された複数のバンプとを備え たことを特徴とする半導体装置。

【請求項6】TABテープの複数のリードに対応して接続される複数のバンプを有する半導体基板と、

前記半導体基板上に形成され、互いに直交するx軸及び y軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線である ベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx成分の50

合計 X b の割合、及び前記ベクトルの y 成分の絶対値の 合計 Y a に対する y 成分の合計 Y b の割合が共に 0.5 以下となるパターンを有する位置認識マークとを備えた ことを特徴とする半導体装置。

【請求項7】前記X b と前記Y b とが共に0でない場合、前記X b と前記Y b との比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の半導体装置。

【請求項8】基板と、

前記基板上に形成され、互いに直交するx軸及びy軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx成分の合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy成分の絶対値の合計Yaに対するy成分の合計Ybの割合が共に0.5以下となるパターンを有する位置認識マークと、

前記位置認識マーク以外の基板上に形成され、半導体装置を実装する配線と、

を備えたことを特徴とするプリント基板。

【請求項9】前記Xbと前記Ybとが共に0でない場合、前記Xbと前記Ybとの比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする請求項8記載のプリント基板。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、位置認識マーク 及びTABテープ及び半導体装置及びプリント基板に係 り、特に接続の際の位置決めの改良に関する。

[0002]

【従来の技術】図10~図14は従来のTABテープ及び位置認識マークを説明する図である。図10(A)に示すように、TABテープ1のインナーリード2が半導体チップ3のアルミニウムバッド上に形成されたバンプ4に位置合わせされている。チップの四隅にはチップの位置を認識するために設けられたアルミニウムの位置認識マーク5が設けられている。デバイスホール7の四隅のTABテープ上には位置認識マーク6が設けられている。。

【0003】とのTABテープの位置認識マーク6はリードバターン2等の形成と同時にウェットエッチングにより銅箔をバターニングして形成される。また、半導体チップ3の位置認識マーク5とバンプ4とは半導体プロセスによって形成されるので、その相対位置関係の精度が良く、その外形寸法と共に1μm以下の誤差となっている。

【0004】図10(B)、図12にTABテープ1の 位置認識マーク6を拡大して示す。図11、図13、図 14にTABテープ1と半導体チップ3を接続した場合 の位置認識マーク6付近を拡大して示す。図中の左上と 右下の位置認識マーク6はTABテープの対角に位置し ている。

0 【0005】18~35μm厚さの銅箔をウェットエッ

2

チングすることによって、半導体チップ3上の位置認識マーク5が形成される。従って、図10(B)に示すように、設計バターン8に対して実線9のようにその形状の角が丸くなる。

【0006】図11に示すように、インナーリード2及びバンプ4のピッチが 50μ m、インナーリード2の幅が 20μ m、バンプ4の上面の幅が約 40μ mとした場合、インナーリード2の端からバンプ4の端までの距離は両側に共に約 10μ mである。この距離が位置ずれに対する余裕となる。

【0007】図示せぬボンディング装置を用いた半導体 チップ3とTABテープ1との自動の位置合わせは、例 えば次のような手順となる。まず、半導体チップ3の位 置認識マーク5とTABテープ1の認識領域12内の位 置認識マーク6とのそれぞれの画像をカメラを用いて取 り込み、その位置と共に記憶させる。その後、リード2 とバンプ4の位置合わせを人間の目で確認しつつ、半導 体チップ3及びTABテープ1の一方を移動させるティ ーチング操作を行う。つまり、ボンディング装置は半導 体チップ3とTABテープ1のそれぞれの位置認識マー 20 ク5、6を認識した位置と、その位置からインナーリー ド2とバンプ4の接続位置までの半導体チップ3及びT ABテープ1の一方の移動方向及び移動距離を記憶す る。との際、一般に半導体チップ3及びデバイスホール 7の対角線部分の位置認識マーク5、6を使用する。 【0008】さらに、自動で実装する半導体チップ3と TABテープとの位置認識マーク5、6の画像を取り込

【0008】さらに、自動で実装する半導体チップ3とTABテープとの位置認識マーク5、6の画像を取り込むと共に記憶する。ティーチング時の半導体チップ3と前記実装する半導体チップ3との位置認識マーク5、6の画像の2次元の相互相関関数を計算し、その極大の位置が両者の相対位置となる。同様に、ティーチング時のTABテープ1と前記実装するTABテープとの認識領域12内の位置認識マーク6の画像の2次元の相互相関関数から両者の相対位置が計算される。二つの相対位置から新たな移動距離が求められる。従って、インナーリード2とバンプ4の位置合わせが自動的に行われる。

【0009】一方、図12(A)(B)に示すように、設計寸法よりオーバーエッチングされて一点鎖線9aのように小さくなったり、アンダーエッチングで点線9bのように大きくなったりする。例えば60μmビッチよ 40り狭ビッチの場合、銅箔の厚さを18μmにし、ウェットエッチングによりパターニンブすると、設計値に対して±10μmの誤差範囲で仕上がる。

【0010】従って、図13中の左上のTABテープの位置認識マーク6がオーバーエッチングされて実線9aのように設計値に対し10μm小さい形状に仕上がり、図13中の右下の位置認識マーク6がアンダーエッチングで実線9bのように設計値に対して10μm大きく仕上がる場合がある。つまり、この場合にティーチングが行われると次に述べるような問題が生じる。

[0011]図14に示すように、上記のティーチング時の条件とは逆にTABテーブ1の図14中の左上で位置認識マーク6が10μmアンダーエッチングで実線10bとなり、図中の右下で10μmオーバーエッチングされて実線10aとなった場合に、上記のティーチングに続いて自動的に位置認識マーク5、6の位置合わせを行う。尚、ティーチングを行った時の位置認識マーク6の外形を点線9a、9bで示している。この時、インナーリード2とパンブ4の位置がずれる。つまり、認識領域12内の実線10a、bがティーチング時の点線9a、9bの位置に合うように、TABテーブが移動されるため、ティーチングした場合の位置に比べてインナーリード2がパンブ4の左上側に20μmずれる。

【0012】上記のように、インナーリード2の端とバンプ4の端の距離が 10μ mである場合、インナーリード2はバンプ4からはみでてしまい接合されず、また、隣のバンプ4同士がショートするという問題があった。【0013】

【発明が解決しようとする課題】上記のように従来のTABテープを用いた半導体チップの実装の場合に、半導体チップのバンプ同士がショートしたり、また、バンプとインナーリードとが接続されないという問題があった。

【0014】との発明の目的は、位置認識による接続部のずれが少なく歩留まりが良い半導体装置及びプリント基板及びそのための位置認識マーク及びTABテープを提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の位置認識マーク及びTABテープ及び半導体装置及びプリント基板においては以下の手段を講じた。請求項1に記載した本発明の位置認識マークは、互いに直交するx軸及びy軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線であるベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx成分の合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy成分の絶対値の合計Yaに対するy成分の合計Ybの割合の少なくとも一方が0.5以下となるパターンを有している。及び、二つの前記パターンの画像を記憶すると共に二つの前記画像の2次元の相互相関関数を計算する位置認識装置によって前記二つの位置の前記パターシの相対位置を算出して位置ずれが検出されることを特徴とする。

【0016】上記本発明の位置認識マークにおいては、位置認識マークが全体的に小さくまたは大きく形成されても、位置認識マークの中心の位置が少なくとも x 軸方向、y 軸方向のいずれかにおいては大きく変化することはない。従って、2次元の相互相関関数を用いた位置認識装置の算出する相対位置によって、少なくとも x 軸方向、y 軸方向のいずれかの方向の実際の位置認識マーク位置が精度良く認識される。つまり、位置認識装置の信

20

頼性を向上させることができる。

【0017】また、請求項2に示すように、前記Xbと 前記Ybとが共に0でない場合、前記Xbと前記Ybと の比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする。 上記本発明の位置認識マークにおいては、前記Xbと前 記Ybとが共にOでない場合、位置認識マークの形状に 少なくとも二つの不連続点があり、その不連続点のx成 分の差とy成分の差が同程度なので、x方向、y方向に 同程度の精度で位置検出が行われる。

【0018】請求項3に記載した本発明のTABテープ 10 は、デバイスホールを有し、樹脂によって形成されたテ ープを備えている。前記テープ上に形成され、互いに直 交するx軸及びy軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合 の各直線であるベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに 対するx成分の合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy 成分の絶対値の合計Yaに対するy成分の合計Ybの割 合が共に0.5以下となるパターンを有する位置認識マ ークを備えている。及び、前記テープ上に形成され、デ バイスホール内に配置される半導体チップ上の複数のバ ンプに対応して接続される複数のリードとを備えてい る。

【0019】上記本発明のTABテープにおいては、位 置認識マークが全体的に大きくまたは小さく形成されて も位置認識マークの位置が大きく変化することがないの で、自動ボンディング装置のTABテープの位置認識マ ークの位置認識の精度を向上させることができる。

【0020】また、請求項4に示すように、前記Xbと 前記Ybとが共に0でない場合、前記Xbと前記Ybと の比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする。 上記本発明のTABテープにおいては、前記Xbと前記 30 Ybとが共にOでない場合、位置認識マークの形状に少 なくとも二つの不連続点があり、その不連続点のx成分 の差とy成分の差が同程度なので、x方向、y方向に同 程度の精度で位置検出が行われる。

【0021】請求項5に記載した本発明の半導体装置 は、デバイスホールを有し樹脂によって形成されたテー プと、互いに直交するx軸及びy軸を仮定し、輪郭を直 線近似した場合の各直線であるベクトルのx成分の絶対 値の合計Xaに対するx成分の合計Xbの割合、及び前 記べクトルのy成分の絶対値の合計Yaに対するy成分 の合計Ybの割合が共にり、5以下となるパターンを有 する位置認識マークと、デバイスホール内に配置される 半導体チップ上の複数のバンプに対応して接続される複 数のリードとからなるTABテープを備えている。前記 デバイスホール内に配置された半導体チップとを備えて いる。及び、前記半導体チップ上に形成され、前記TA Bテープの複数のリードに対応して接続された複数のバ ンプとを備えている。

【0022】上記本発明の半導体装置においては、ボン ディング装置によるボンディング時の位置認識マークの 50 なくとも二つの不連続点があり、その不連続点のx成分

位置認識の精度が高いので、TABターブのリードと半 導体チップのバンプの位置ずれが小さく抑えられて確実 に接続される。従って、半導体装置の接続部の信頼性を

向上させることができる。

【0023】請求項6に記載した本発明の半導体装置 は、TABテープの複数のリードに対応して接続される 複数のパンプを有する半導体基板を備えている。及び、 前記半導体基板上に形成され、互いに直交するx軸及び y軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線である ベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx成分の 合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy成分の絶対値の 合計 Yaに対する y 成分の合計 Ybの割合が共に 0.5 以下となるパターンを有する位置認識マークを備えてい

【0024】上記本発明の半導体装置においては、位置 認識マークが全体的に大きくまたは小さく形成されても 位置認識マークの位置が大きく変化することがないの で、自動ボンディング装置の半導体基板の位置認識マー クの位置認識の精度が向上する。従って、前記TABテ ープの前記リードと前記半導体基板の前記パンプとの接 続の信頼性を向上させることができる。

【0025】また、請求項7に示すように、前記Xbと 前記Ybとが共にOでない場合、前記Xbと前記Ybと の比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする。 上記本発明の半導体装置においては、前記X b と前記Y bとが共に0でない場合、位置認識マークの形状に少な くとも二つの不連続点があり、その不連続点のx成分の 差とy成分の差が同程度なので、x方向、y方向に同程 度の精度で位置検出が行われる。

【0026】請求項8に記載した本発明のプリント基板 は、基板と、前記基板上に形成され、互いに直交するx 軸及びy軸を仮定し、輪郭を直線近似した場合の各直線 であるベクトルのx成分の絶対値の合計Xaに対するx 成分の合計Xbの割合、及び前記ベクトルのy成分の絶 対値の合計Yaに対するy成分の合計Ybの割合が共に 0. 5以下となるパターンを有する位置認識マークを備 えている。及び、前記位置認識マーク以外の基板上に形 成され、半導体装置を実装する配線を備えている。

【0027】上記本発明のプリント基板においては、位 置認識マークが大きくまたは小さくなっても、その中心 の位置が大きく変化することがない。従って、半導体チ ップ等の電子部品を実装する際、位置認識マークを用い た自動的な位置合わせによって、ブリント基板の位置決 めの精度が向上する。

【0028】また、請求項9に示すように、前記Xbと 前記Ybとが共にOでない場合、前記Xbと前記Ybと の比が0.8以上1.2以下であることを特徴とする。 上記本発明のプリント基板においては、前記Xbと前記 Ybとが共にOでない場合、位置認識マークの形状に少

の差とy成分の差が同程度なので、x方向、y方向に同 程度の精度で位置検出が行われる。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。尚、図10~13と同一部 分には同一符号を付し、異なる部分についてのみ説明す る。

(第1の実施の形態)図1~図7に、本発明の第1の実 施の形態の構成を示す。

【0030】図1に示すようなTABテープの場合につ いて説明する。位置合わせ用の位置認識マーク6は実線 9と実線11との形状からなる。この位置認識マーク6 はインナーリード2と同時にエッチングによって形成さ れる。オーバーエッチングされた場合は一点鎖線9a、 一点鎖線 1 1 a の形状となり、アンダーエッチングの場 合は点線9 b、点線11 bの形状となる。このように形 状が円の場合はオーバーエッチング及びアンダーエッチ ングによってその中心はほとんど変化しない。従って、 ティーチングに使用する位置認識マーク6がオーバーエ ッチングまたはアンダーエッチングされた場合でも、そ 20 の位置認識マーク6が相関関数を計算するかあるいは相 関関数の考え方に基づいてパターンマッチングして認識 されるため、実装時の実線11、一点鎖線11a、点線 11bの円の中心がティーチングした時点の実線11、 一点鎖線11a、点線11bの円の中心と一致し、リー ド2とバンブ4の位置ずれが起こらない。

【0031】図2(A)(C)に示すように、位置認識 マーク6の形状は実線13の正方形でもよい。図2

(B) は図2(A)の2B-2Bにおける断面であり、 図2 (D) は図2 (C) の2 D-2 Dにおける断面であ 30 る。図2(B)に示すように、この正方形の形状13は 貫通した穴13aでもよく、また、図2(D)に示すよ うに貫通しない穴13bでもよい。貫通しない穴13b は銅箔の厚さの途中までエッチングすることで形成され る。また、円及び正方形に限らず、認識領域12の中に 入る閉じた形状でよい。等方性の点からは円のような点 対称な図形または正多角形が望ましいが、後述するよう に必ずしも閉じた形状でなくともよい。

【0032】次に、上記位置認識マークの形状について 図3~図5を用いて詳しく説明する。図3(A)(B) に示す位置認識マークの形状は実線11の円である。実 線11を囲むように認識領域12である正方形枠が設定 される。実線11は右回りにベクトル11~18により 直線近似(多角形による近似でもよい)される。認識領 域12の図3中の右方向にx軸の正方向、上方向にy軸 の正方向を取ると、ベクトル 1 1 はx、y成分とも正の 値x1、y1を持つ。同様に、12も正の値の成分x 2、y2を持つ。13はx成分は正であるがy成分は負 である。順次18まで成分を求めx1~x8、y1~y 8が得られる。この各成分の絶対値の和をXa、Yaと 50 a、Yb/Yaが30%とする。その場合、エッチング

し、各成分の和をXb、Ybとおく。

【0033】位置認識マークである実線11が閉じてい るので、各成分の和Xb、Ybはそれぞれ0になる。左 回りに輪郭に沿って近似を行っても同様にx、y成分の 合計Xb、YbはOになる。この場合、ベクトル11~ 18の順に対して、x成分とy成分が共に正、x成分が 正でy成分が負、x成分とy成分が共に負、x成分が負 でy成分が正の四つの区間がその順に等間隔にある。ま た、ベクトル11~18を対称に取ると、XaとYaと の比が1となる。

【0034】図3(C)(D)に示す位置認識マークの 形状は実線13の正方形である。この場合も同様に、位 置認識マークの実線13が閉じているので、その実線1 3を近似するベクトル | 1~1 | 6のx成分x 1~x 1 6、y成分yl~yl6の合計Xb、Ybはそれぞれ0 になる。この場合、ベクトル11~116の順に対し て、x成分が正でy成分がO、x成分がOでy成分が 負、x成分が負でy成分が0、x成分が0でy成分が正 の四つの区間がその順に等間隔にある。また、XaとY aとの比が1となっている。

【0035】図4(A)(B)に図3(A)(B)の位 **置認識マークである実線11の実際の概観を示す。ま** た、図4 (B) の認識領域12内の実線14に示される 別の位置認識マークについて次に説明する。

【0036】図5(A)(B)の位置認識マークの実線 14の形状は認識領域12内で閉じていない。その実線 14を近似するベクトル11~18が小さければ、その 各x成分の絶対値の和Xaに対して、x成分の和Xbの 割合は約30%以下になる。同様に、11~18を小さ くすれば、各y成分の絶対値の和Yaに対して、y成分 の和の割合Ybは約30%以下になる。尚、認識領域1 2内の不連続点では認識領域12の境界に沿って次の不 連続点に移動するということにする。この定義によって 回転方向を決め、右回り及び左回りの一方に設定する。 とのように設定したベクトル11~18の順に対して、 x成分が正でy成分が0、x成分とy成分が共に正、x 成分が正でy成分が負、x成分とy成分が共に負、x成 分が 0 で y 成分が負の五つの区間がその順にある。

【0037】図5(C)(D)は位置認識マークとして 実線15a、実線15bのような他の形状を示す図であ る。x1、x2の和とx3、x4の和、及び、y1、y 2の和とy3、y4の和がそれぞれ同じならば、図3 (A)~(D)、図5(A)(B)の場合と同じ効果と なる。この場合、x成分が正でy成分が0、x成分が0 でy成分が正、不連続点の移動後、x成分が負でy成分 がO、x成分がOでy成分が負の四つの区間がその順に 等間隔にある。また、XaとYaとの比が1である。

【0038】前述のバンプ4とインナーリード2の実験 の場合、図5(A)(B)の形状で前記割合Xb/X

10

誤差によるティーチング時と実装時の最大のずれ(以 下、ティーチングずれの最大値と記す)の20μmの3 0%(以下、実装ずれの最大値と記す)、すなわちx方 向、y方向にそれぞれ約6 μmのずれを生じる可能性が ある。位置ずれに対する余裕10μmよりもこの実装ず れの最大値6μmが小さいので、従来のバンプ4のサイ ズとインナーリード2の幅の場合でも、インナーリード 2とバンブ4が十分に接合される。つまり、前記割合を 50%以下とすると、実装ずれの最大値は10μmとな り位置ずれの余裕10μmと同じになるので、インナー リード2をバンプ4に接合できる。一方、従来例のよう なし字型ならば、位置認識マーク6の実線9のどの位置 の輪郭を用いても、割合Xb/Xa、Yb/Yaは10 0%となる。つまり、この場合、エッチング誤差が±1 0μmの時のティーチングずれの最大値20μmに対 し、実装ずれの最大値は100%でx方向、y方向に2 0μmとなる場合が生じる。

【0039】Xb、Ybが共に0でない場合、実験によるとXbのYbに対する比が0.8~1.2の間であることが望ましい。この場合、位置認識マークの形状の二 20つの不連続点(例えば、この点を近似の開始点と終了点に取ることができる)のx成分の差、y成分の差が同程度であるので、形状変化に対してX軸、Y軸方向の両方向の認識精度が同程度となる。従って、X軸、Y軸に対する斜め方向にもずれが生じにくい。また、位置検出の精度の等方性の点からx方向、y方向の変化の範囲またはXa、Yaの値が等しくなっている。しかし、必ずしも等しくなくてもよい。

【0040】合計Xa、Yaが大きな値を取るようにすれば、位置認識に用いられる近似ベクトルの数が多くな 30 り、近似の精度は高くなる。この場合に、割合Xb/Xa、Yb/Yaが小さい形状であれば、エッチング誤差による位置合わせのずれを小さくすることが可能となる。また、上記の場合、認識領域12内の形状が一つで相関関数が一つの最大値を持つ場合であるが、認識領域12内に形状が複数あってもよい。一方、細長い長方形の場合は、長軸の方向の位置認識可能な範囲は広く、端軸の方向の位置認識の感度は高くなる。従って、これらの形状を数種類組み合わせて位置認識の範囲を広くし及びその精度を上げることも可能である。尚、入り組んだ 40複雑な形状であっても相関関数による位置認識が行われる。この場合も上記のように、Xb/Xa、Yb/Yaの比が小さいほうが望ましい。

【0041】図6(A)(B)は、位置認識マークの別の例15cを示す図である。図6(A)(B)に示すように、その形状は二つの長方形を組み合わせてT字状になっている。その長方形の先端は半円状になっている。この形状は位置認識領域12内で閉じていない。この場合、互いに直角な二つの方向についての感度が高い。従って、上述したように、位置認識の精度が高い。

【0042】本発明の実施の形態においては、位置認識マークがオーバーエッチングまたはアンダーエッチングされても、認識領域12内の位置認識マークの中心の位置が大きく変化することがないので、ボンディング装置の位置認識マークの自動位置合わせの精度が向上する。さらに、従来の位置認識装置をそのまま使用し、インナーリード2とバンブ4の位置ずれが小さく抑えられて確実に接続され、半導体装置の接続部の信頼性が向上する。

【0043】また、図7に示すように、金属をエッチングまたはビルトアップすることによってTABテープ1上に位置認識マーク16を凸状に形成しても同じ効果を有する。また、金属の代わりに樹脂を用いて位置認識マーク16を形成してもよい。尚、オーバーエッチング等によって小さくなる場合は一点鎖線16aの形状、アンダーエッチング等によって大きくなる場合は点線16bとなる。

【0044】半導体チップ1の位置認識マーク5の形状を本発明の実施の形態の位置認識マークと同じにしても同じ効果がある。さらに、TABテープ及び半導体チップ1の位置認識マークを共に本発明の実施の形態の位置認識マークにすると相乗効果によって、位置合わせの精度が向上する。また、比較的狭いビッチの半導体チップのバンプとTABテープのインナーリードとを接続することが可能となる。TABテープ及び半導体装置の位置認識マークを別の形状にしてもよい。また、TABテープ上及び半導体装置上の対角にある位置認識マークを別の形状にしてもよい。

(第2の実施の形態)図8、図9に、本発明の第2の実施の形態の構成を示す。

[0045] この実施の形態はブリント基板の場合であり、位置認識マークの形状は第1の実施の形態と同じである。図8(A)に示すように、エポキシ系部材の基板17上に実線18及び円20の位置認識マーク19を設ける。この位置認識マーク19は金属配線21と同時にエッチングによって形成される。金属配線21は図示せぬ半導体装置の端子に接続される。図8(B)はこの実施の形態の形成時における図8(A)の8B-8Bでの断面図である。位置認識マーク19の上にレジスト22が形成されている。図8(A)(B)に示すように、第1の実施の形態と同様に、位置認識マーク19の形状について、オーバーエッチングの場合は一点鎖線18a、一点鎖線20aとなり、アンダーエッチングの場合は点線18b、点線20bとなる。

【0046】また、図9に示すように、基板17上に金属の凸状の位置認識マーク23を設ける。この位置認識マーク23は金属配線24と同時にビルトアップされる。図9(B)はこの実施の形態の形成時における図9(A)の9B-9Bにおける断面図である。図9(B) に示すように、位置認識マーク23の形成時には、基板

20の上に金属のメッキ25が形成されており、その上にレジスト26が位置認識マーク23及び金属配線24の形成予定領域を除く領域に形成されている。この位置認識マーク23及び金属配線24の形成予定領域に銅またはチタン等の金属をビルトアップして、位置認識マーク23及び金属配線24を形成する。尚、位置認識マーク23形成後、レジスト25と、金属配線24及び位置認識マーク23以外の領域の金属メッキ25とは除去される。

【0047】金属の堆積または成長が多いと一点鎖線2 10 3 a、一点鎖線24 a のように、レジスト26を圧迫して大きさが大きくる。この堆積または成長が少ないと点線23b、点線24bのように、小さい形状となる。

【0048】尚、基板17に実装される半導体装置に位置認識マークを形成してもよい。第2の実施の形態においては、第1の実施の形態と同様に、位置認識マーク20、23が大きくまたは小さくなっても、その中心の位置が大きく変化することがない。従って、半導体装置等の電子部品を実装する際、位置認識マーク20、23を用いた自動的な位置合わせによって、配線と電子部品の20端子との位置ずれが小さく抑えられる。つまり、配線と電子部品とがベーストはんだ、フリップチップ法等によって確実に接続される。結局、電子部品が実装されたプリント基板の接続部の信頼性が向上する。さらに、比較的狭いビッチの半導体チップの端子とプリント基板の配線を接続することが可能となる。

【0049】また、第1及び第2の実施の形態の位置認識マークは、金属に限らず樹脂、シリコン及びガリウムヒ素等の半導体、その半導体上の酸化膜層及び金属層でもよい。また、上記の位置認識の方法は相関関数による30方法に限らず、相似な形状であれば大きさに影響を受けない方法ならばよい。

[0050]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、位置認識による接続部のずれが少なく歩留まりが良い半導体装置及びプリント基板及びそのための位置認識マーク及びTABテープを提供できる。

【図面の簡単な説明】

12

【図1】本発明の実施の形態に係るTABテープを説明 する図。

【図2】本発明の実施の形態に係る位置認識マークを説明する図で、(A)、(C)は平面図、(B)、(D)は断面図。

【図3】本発明の実施の形態の位置認識マークを説明する図で、(A)~(D)は平面図。

【図4】本発明の実施の形態に係るTABテープを説明する図で、(A)、(B)は拡大図。

【図5】本発明の実施の形態の位置認識マークを説明する図で、(A)~(D)は平面図。

【図6】本発明の実施の形態の位置認識マークを説明する図で、(A)、(B)は平面図。

【図7】本発明の実施の形態に係るTABテープを説明 する図。

【図8】本発明の実施の形態に係るプリント基板を説明する図で、(A)は平面図、(B)は図8(A)における8B-8Bにおける断面図。

【図9】本発明の実施の形態に係るブリント基板を説明 0 する図で、(A)は平面図、(B)は図9(A)の9B -9Bにおける断面図。

【図10】従来のTABテーブの一例を説明する図で、

(A) は全体図、(B) はその一部の拡大図。

【図11】従来のTABテープの一例を説明する図。

【図12】従来のTABテープに係る位置認識マークを 説明する図。

【図13】従来のTABテープの一例を説明する図。

【図14】従来のTABテープの一例を説明する図。 【符号の説明】

30 1…TABテープ、

2…インナリード、

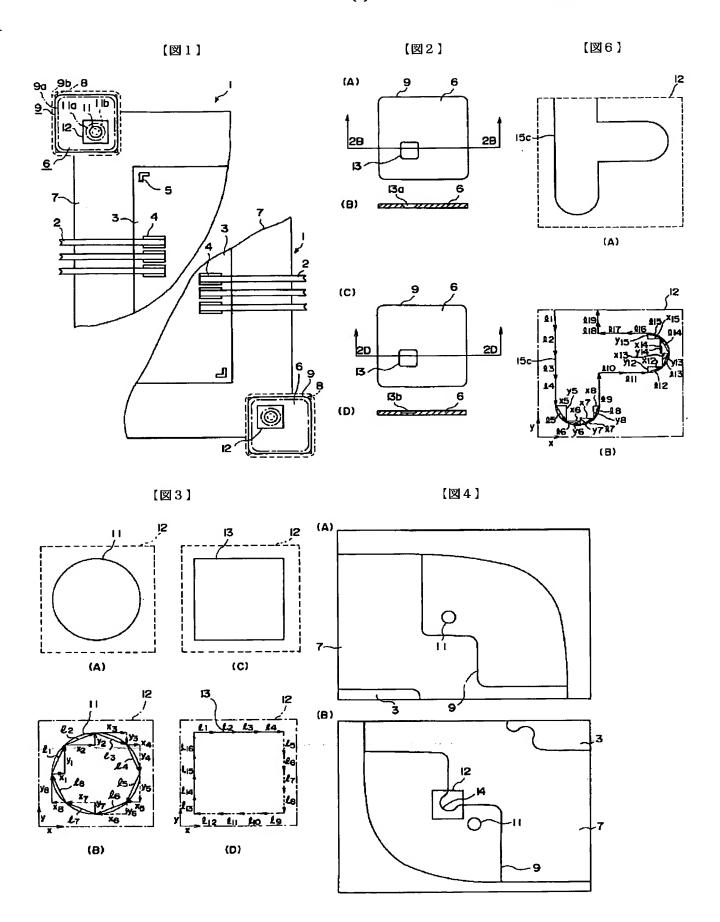
3…半導体チップ、

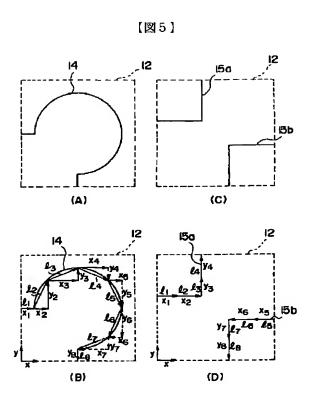
4…バンプ、

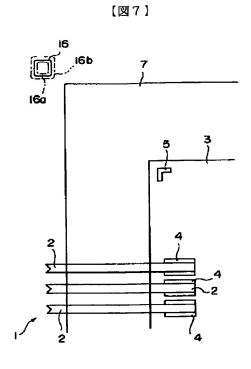
6、11、11a、11b、13、14、15a、15 b、16、16a、16b、19、20、20a、20 b、23、23a、23b…位置認識マーク、

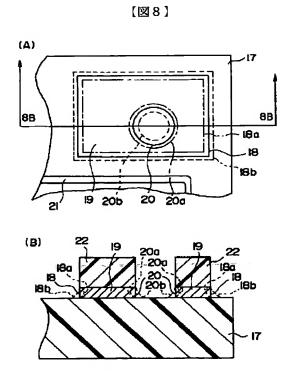
17…プリント基板、

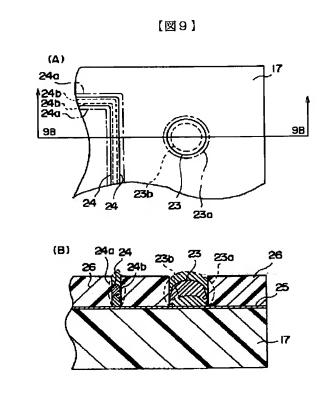
21、24…金属配線。

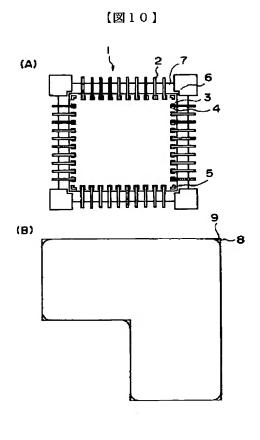


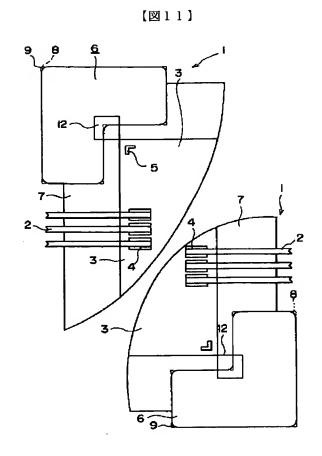




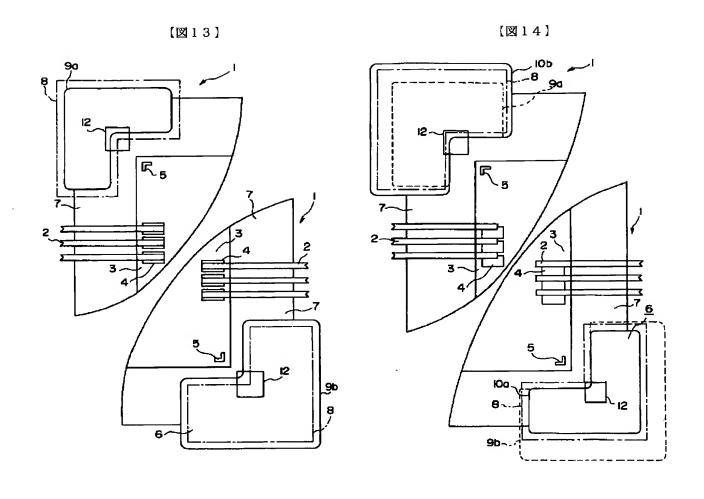








(A) 8 9b 9a 9b 8 (B)



フロントページの続き

(72)発明者 細美 英一 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 柴崎 康司 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社内